i 文

# Cu-Ag-Ti三元系ろうによるシリコン系 セラミックスの接合における強度支配因子

機械金属部 金属研究室 玉井富士夫

高温構造材料として期待されているシリコン系セラミックスの活性金属ろうによる接合 強度の支配因子を明らかにする目的で、Agの添加量を変えたCu-Ag-Tiろうを用いて、SiC/ SiCおよびSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合を行った。接合後、接合部の組織観察、分析および4点曲げ強 度試験を行い、接合部の強度特性と組織、接合部の強化メカニズムについて考察した。得 られた結果をまとめると以下のとおりである。

- (1) SiC/SiC接合体の強度はSiC/ろう界面およびその界面近くに形成されるCuによる浸入層 が支配している。Ag濃度の違いにより、Cuによる浸入層のポアサイズが変化し、SiC/SiC 接合体の強度に大きく影響する。
- (2) Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体の強度は接合層のろう合金部が支配しており、ろう合金中に生成されるTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>のVf%およびその分布形態に影響を受ける。ろう合金中に生成されるTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>のVf%が多くなると接合層が分散強化されるが、Ag自体はTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>の生成量に直接関係しないため、Ag濃度はSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体の強度にあまり影響しない。

#### .緒 言

SiCおよびSi<sub>3</sub>N₄に代表されるシリコン系セラミッ 2スの接合に関し,我々はこれまでTi濃度を変えた u-Ti合金やCu-Ag-Tiろうを用いて,SiC/SiCおよび 3N₄/Si<sub>3</sub>N₄接合を行い,接合のメカニズムや接合部 D組織,強度について検討を行ってきた<sup>1)~3)</sup>。

本研究では、SiCおよびSiaN4の接合部強度特性支 記因子を明らかにする目的で、Agの添加量を変化さ またCu-Ag-Ti三元系ろうを用いて、SiC/SiCおよび iaN4/SiaN4接合を行い、これまでの一連の研究結果 )~<sup>3)</sup>と比較し、接合部強度特性支配因子について定 量的に検討した。

### . 材料および実験方法

実験に用いたセラミックスは市販の常圧焼結した 反状のSiCおよびSi₃N₄である。Table1にその化学組 皮をTable2に代表的力学的性質を示す。この供試材 Tablel Chemical compositions of ceramics used. (wt%)

	SiC	Si3N4	A1	Fe	C	Ca	Mg	0
SiC	98		. 02	. 06	. 6			
Si 3N4		98	. 12	. 12	. 1	. 07	. 01	1.5

Table2 Mechanical properties of ceramics used.

	Bending strength σзь (MPa)	Young's modulus E(kN/mm²)	Fracture tougfness Kıc(MPa•m <sup>1/2</sup> )
SiC	830	390	4.6
Si3N4	780	290	6.0

料を切断・研削加工し, 10×15×20mm形状の接合用 試験片を作製した。用いたCu-Ag-TiろうはAg濃度を 変えた(Cu100 ×Ag×)95Ti5 (SiC接合用), (Cu100 × Ag×)85Ti15 (Si3N4接合用)の2系統12種類の積層箔 である。ここで, これらのろうにおけるTi濃度は著 者らの研究により, SiC/SiC接合で5at%が, Si3N4/ SiaN4接合で15at%が,強度特性の観点から最適であることがわかっている<sup>3)</sup>。

これらのろうをセラミックス間に挟み,10<sup>3</sup>Paの 真空中で温度1323K,時間1.8ks加熱し,接合を行っ た。接合後,JISR1601に準拠した四点曲げ試験を行 い,接合部の強度特性を評価した。併せて,接合部 の組織観察,EPMAによる分析等を行い,接合部界面 の反応および反応生成物について検討し,強度支配 因子について考察した。

#### 3. 結果および考察

## 3.1 接合体の強度と組織

Fig.1にSiC/SiC接合体およびSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体の 四点曲げ試験結果を曲げ強度とAg濃度の関係に整理 して示す。Agの添加効果は明らかであり、Agを添加 することで両者とも同一Ti濃度のCu-Ti合金を用いた 場合に比べ、強度が相当大きくなっている。

また, SiC/SiC接合の場合, 強度に明らかなAg濃度 依存性が認められ, 10at%Ag濃度で270MPaの最大強度 となっており, Ag濃度が10at%を越えると徐々に強度 は小さくなっている。一方, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合の場合, 10at%Ag濃度以上では強度にAg濃度依存性はほとんど 認められず, おおよそ400MPaのほぼ一定の強度を示 す。



Fig. 1 Effects of Ag content for bending strength of SiC joints and Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> joints.

Fig. 2にSiC/SiC接合部の組織観察結果を示す。(a) が(Cu<sub>90</sub>Ag<sub>10</sub>)<sub>95</sub>Ti<sub>5</sub>ろうを,(b)が(Cu<sub>70</sub>Ag<sub>30</sub>)<sub>95</sub>Ti<sub>5</sub>ろ うをそれぞれ用いた場合の接合部組織である。(a), (b)ともにSiC接合界面にTiC反応層が生成している。 内部のろう合金部は少量のSiを固溶したCu合金とな っており,Agの相が細かく分散している。また,Ti C反応層とSiCの間には,Cuによると考えられるポー ラスな浸入層の存在が認められる。この浸入層の厚 さはAg濃度の増加とともに徐々に薄くなる傾向が見 られ,60at%Ag濃度では観察されなくなる。しかし, 60at%Ag濃度では,SiC/TiC反応層界面に界面剝離が 観察される。

Fig. 3にSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合部の組織観察結果を示す。 (a)が(Cu<sub>5</sub>oAg<sub>1</sub>o)s<sub>5</sub>Ti<sub>1</sub>5ろうを,(b)が(Cu<sub>5</sub>oAg<sub>4</sub>o)s<sub>5</sub> Ti<sub>1</sub>5ろうをそれぞれ用いた場合の接合部組織であ (a),(b)ともにSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合界面にTiN反応層が,内部 のろう合金内にTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>生成物が生成しており,TiNの 厚さやTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>生成物の量はAg濃度によらず,ほぼ一 定している。また,内部のろう合金部は微量のSiを 固溶したCu合金となっており,Agの相が細かく分散 している。



(a)By using (CueoAgio)esTis (b)By using(CuroAgio)esTis Fig. 2 Microstructure of SiC/SiC joints.





(a)By using (CusoAgio)85Tii5 (b)By using(CusoAgio)85Tii5 Fig. 3 Microstructure of SiaN4/SiaN4 joints.

## .2 強度支配因子

SiC/SiC接合体およびSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体の強度が 安合体のどの部分にどういうメカニズムで支配され
 ているかを考察することは、高強度・高信頼性接合
 支術を開発する上で非常に重要と考える。

Fig.1で示した接合体の四点曲げ試験において, iC/SiC接合体の破壊はTiC反応層とSiCの間に形成さ 1る浸入層部もしくはSiC/TiC反応層界面剝離部で生 じている。また、Cu-Ti合金ろうおよびTi濃度を変え と(Cu<sub>39,9</sub>-Ag<sub>60,1</sub>)100-xTixろうを用いた同様の研究 <sup>),3)</sup>においてもSiC/SiC接合体の破壊はTiC反応層と iCの間に形成される浸入層部で生じていた。従って, liC/SiC接合体の強度はCuによる浸入層に支配されて うると考えられる。Fig.4にSiC/SiC接合体のCuによ る浸入層厚さおよび浸入層に形成される平均ポアサ イズとろう中のAg濃度の関係を示す。この浸入層は ポーラスでブリットルな性状のため、Cu-Ti合金ろう およびTi濃度を変えた(Cu39.9-Ag60.1)100-xTixろう を用いた同様の研究1),3)では、浸入層の厚さが接合 本の強度に影響し、厚さが薄くなるほど強度は大き くなっていた。しかし,本研究では, Fig.4に示すよ うにAg濃度の増加により浸入層の厚さは薄くなるが, 逆に接合体の強度は小さくなっている。<br />
浸入層の厚 さだけでは接合体の強度特性を説明できない。EPMA



Fig. 4 Effects of Ag content for thickness and pore size of penetrating layers.

による浸入層の詳細な観察と分析を行った結果,こ の浸入層部からAgが検出され,Ag濃度の違いにより 浸入層のポアサイズに違いが認められた。つまり, Fig.4に示すように浸入層のポアサイズはAg濃度が 10at%の0.4µmからAg濃度が40at%の1.8µmまで,Ag濃 度の増加によりしだいに大きくなる。Cu-Ag-Tiろう のAg濃度を増加させた場合,浸入層の厚さはTi濃度 を変化させた場合ほど大幅に薄くはならず,浸入層 のポアサイズの違いが強度に大きく影響したと考え られる。

一方, Fig. 1で示した接合体の四点曲げ試験におい て, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体の破壊は全て接合層内部のろ う合金部で生じている。また, Cu-Ti合金ろうおよび Ti濃度を変えた(Cu<sub>3</sub>9, 9-Ag<sub>6</sub>0, 1)100-xTixろうを用い た同様の研究<sup>2),3)</sup>においてもSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体の 破壊はSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>母材破壊した場合を除き,接合層内部の ろう合金部で生じていた。従って,Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合 体の強度は接合層内部のろう合金部に支配されてい ると考えられる。Fig. 5にSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体のろう 合金中に生成されるTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>のVf%とろう中のAg濃度の 関係を示す。また,比較のためCu-Ti合金を用いた場 合のろう合金中に生成されるTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>のVf%とろう中の Ti濃度の関係<sup>2)</sup>を実線で併せて示す。Ti濃度を変化 させた場合には,Ti<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>のVf%つまり接合体のろう合 金部の分散強化の程度が変化するが,Ag濃度を変化



Fig.5 Effects of Ag content and Ti content for Vf% of Ti₅Si₃ in joining layer.

させてもTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>による接合体のろう合金部の分散強 化の程度はほとんど変化せず, Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体の 強度はほぼ一定となると考えられる。

## 4.まとめ

Agの添加量を変えたCu-Ag-Tiろうを用いて,SiC/ SiCおよびSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合を行った。接合後,接合 部の組織観察,分析および4点曲げ強度試験を行い, 接合部の強度特性と組織,接合部の強化メカニズム について考察した。

得られた結果をまとめると以下のとおりである。

- (1) SiC/SiC接合体の強度はSiC/ろう界面およびその 界面近くに形成されるCuによる浸入層が支配して いる。Ag濃度の違いにより、Cuによる浸入層のポ アサイズが変化し、SiC/SiC接合体の強度に大きく 影響する。
- (2) Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体の強度は接合層のろう合金部

が支配しており,ろう合金中に生成されるTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub> のVf%およびその分布形態に影響を受ける。ろう合 金中に生成されるTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>のVf%が多くなると接合層 が分散強化されるが,Ag自体はTi<sub>5</sub>Si<sub>3</sub>の生成量に 直接関係しないため,Ag濃度はSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体 の強度にあまり影響しない。

(この研究は大阪大学溶接工学研究所との共同研究 により行われました。)

# 参考文献

- 1) 玉井, 奈賀; Cu-Ti 合金によるSiC/SiC接合体の組 織と強度, 溶接学会論文集, 投稿中.
- 2) 玉井,奈賀; Cu-Ti合金によるSi<sub>3</sub>N<sub>4</sub>/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>接合体の組織と強度,溶接学会論文集,投稿中.
- 3) 玉井;大阪大学溶接工学研究所共同研究報告書, 74-p108(1993).